

中小企業 SiC パワーデバイス活用研究会 第3回 SiC 基礎セミナーの開催について

平成29年2月16日
京都府中小企業技術センター
担当：応用技術課（堀）
電話：075-315-8634

近年、電力変換や制御を行う半導体（パワーデバイス）材料には、従来のSi（シリコン）に代わりSiC（シリコンカーバイド）を活用した、より省エネ型の高効率エネルギー利用システム構築に注目が集まっており、京都においても、（独）科学技術振興機構の公募事業に採択された「スーパークラスタープログラム（クリーン・低環境負荷社会を実現する高効率エネルギー利用システムの構築）」が推進されているところです。

このような中、当センターにおいても、このプロジェクトと連動し、低環境負荷社会の実現、地域企業の活性化と地域産業の振興に寄与することを目的とする「中小企業 SiC パワーデバイス活用研究会」を平成26年に設立しており、その一環として「第3回 SiC 基礎セミナー」を開催いたします。

併せて、平成28年度 JKA 機械工業振興補助事業により導入した電磁波妨害評価試験装置の見学会を行います。

- 1 日 時 平成29年3月6日（月） 14時00分～16時00分
2 場 所 京都府産業支援センター 5階 研修室
（京都市下京区中堂寺南町134）

3 プログラム

・ はじめに

^{ふなき} ^{つよし}
舟木 剛 氏 大阪大学大学院工学研究科 電気電子情報工学専攻 教授

・ 講演

「ワイドバンドギャップパワー半導体デバイスの最新技術
～GaN、SiC デバイスとアプリケーション事例～」

^{たかはし} ^{さとる}
高橋 理 氏 パナソニック株式会社 AIS 社 インダストリアル事業開発センター 主幹

（概要）同社にて開発の GaN および SiC パワーデバイスの最新技術について紹介します。

高速動作かつ機器の安定動作を可能とする独自のノーマリオフ型 GaN トランジスタ GIT (Gate Injection Transistor)、ダイオード内蔵により素子の大幅な小型化を実現する SiC トランジスタ DioMOS (Diode-integrated MOSFET) に関して、その特長とパワエレスイッチング機器への応用事例について報告します。

・ 試験機器見学会

「電磁波妨害評価試験装置」

（概要）今年度、京都府中小企業技術センターに納入され、車載機器などの電気・電子製品に要求される電磁ノイズ試験 (EMC 試験) が可能な試験装置の見学会を行います。



- 4 定 員 60名
5 参加費 無料
6 締 切 定員に達し次第
7 問合・申込先

京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気・電子担当
〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134（京都府産業支援センター内）
電話：075-315-8634 FAX：075-315-9497 E-mail：ouyou@mtc.pref.kyoto.lg.jp
当センターのホームページ（<http://www.mtc.pref.kyoto.lg.jp>）からお申し込みできます。

